

2Т360А-1, 2Т360Б-1, 2Т360В-1

Бескорпусные высокочастотные биполярные р-р-р транзисторы малой мощности

Типовое значение граничной частоты передачи тока $f_T = 550$ МГц

Максимальная рассеиваемая мощность коллектора $P_{Kmax} = 10$ мВт

Максимальное постоянное напряжение коллектор-эмиттер $U_{Kэmax} = 20$ В(2Т360А-1); 15В(2Т360Б-1, 2Т360В-1)

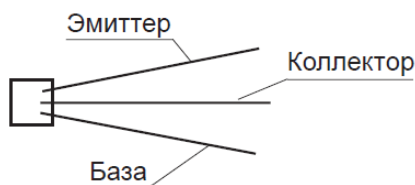
Тип изделия	НомерТУ	Тип корпуса
2Т360А-1, 2Т360Б-1, 2Т360В-1	ЩТЗ.365.059 ТУ	Без корпуса, сопроводительная тара ТС1, ТС16

Бескорпусные кремниевые планарно-эпитаксиальные р-р-р усилительные транзисторы 2Т360А-1, 2Т360Б-1, 2Т360В-1 предназначены для использования в неремонтируемых гибридных схемах, микромодулях, узлах и блоках радиоэлектронной аппаратуры.

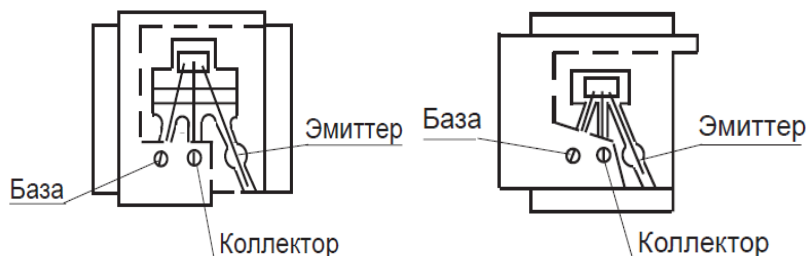
Маркировка транзисторов соответствует техническим условиям ЩТЗ.365.059 ТУ.

Знаком Н обозначаются изделия повышенной надежности. Размер кристалла 0,5 x 0,6 мм.

Схема расположения выводов



Сопроводительная тара



2Т360А-1, 2Т3108Б-1, 2Т3108В-1

ТС1

ТС16

Основные электрические параметры при температуре: 0°C ÷ + 70°C

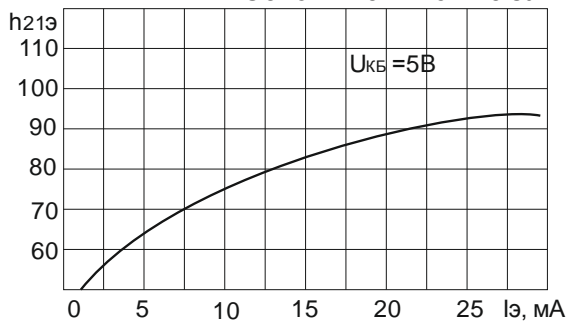
Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквен- ное обозна- чение	2Т360А-1		2Т360Б-1		2Т360В-1	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Обратный ток коллектора, мкА ($U_{КБ}=25$ В для 2Т360А-1; $U_{КБ}=20$ В для 2Т360Б-1, 2Т360В-1)	$I_{КБО}$		1		1		1
Обратный ток эмиттера, мкА ($U_{ЭБ}=5$ В для 2Т360А-1; $U_{ЭБ}=4$ В для 2Т360Б-1, 2Т360В-1)	$I_{ЭБО}$		0,5		0,5		0,5
Статический коэффициент передачи тока ($U_{КБ}=1$ В, $I_{Э}=10$ мА, $t_{и} < 2$ мс)	$h_{21Э}$	25	70	40	120	80	240
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{КБ}=2$ В, $I_{Э}=5$ мА, $f=100$ МГц)	$ h_{21Э} $	3		4		4	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ($I_{К}=10$ мА, $I_{Б}=1$ мА)	$U_{КЭнас}$		0,35		0,35		0,35
Напряжение насыщения база- эмиттер ($I_{К}=10$ мА, $I_{Б}=1$ мА), В	$U_{БЭнас}$		1,2		1,2		1,2
Постоянная времени цепи обрат- ной связи на высокой частоте, пс ($U_{КБ}=2$ В, $I_{Э}=5$ мА, $f=5$ МГц)	τ_K		450		450		450
Емкость коллекторного перехода ($U_{КБ}=5$ В, $f=10$ МГц), пФ	C_K		5		5		5
Емкость эмиттерного перехода ($U_{ЭБ}=0$ В, $f=10$ МГц), пФ	$C_Э$		7		7		7



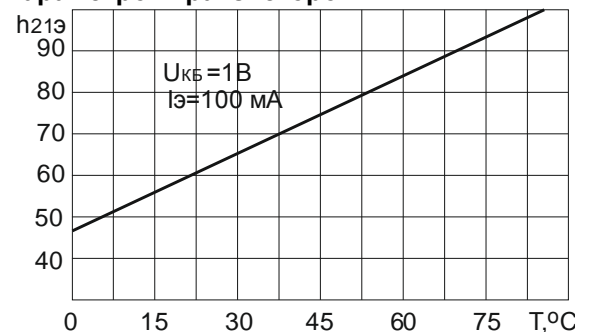
Предельные значения допустимых электрических режимов эксплуатации

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	2Т360А-1	2Т360Б-1	2Т360В-1	Примечание
Максимально – допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	$U_{КБmax}$	25	20	20	
Максимально – допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 10 \text{ кОм}$, В	$U_{КЭmax}$	20	15	15	
Максимально – допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$U_{ЭБmax}$	5	4	4	
Максимально – допустимый постоянный ток коллектора, мА	$I_{Кmax}$	20	20	20	
Импульсный ток коллектора при $t_{и} \leq 1 \text{ мкс}$, $Q \geq 10$, мА	$I_{КИmax}$	75	75	75	
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора, мВт	$P_{Кmax}$	10	10	10	
Общее тепловое сопротивление, $^{\circ}\text{C}/\text{мВт}$	$R_{Т-п-с}$	7	7	7	

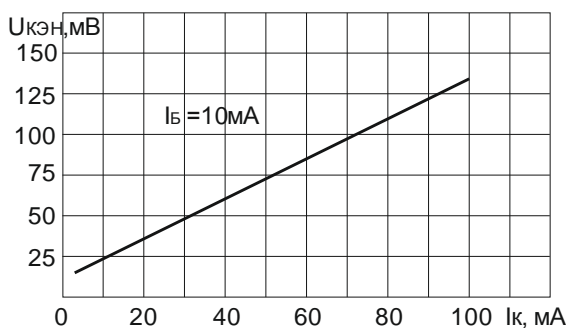
Основные типовые зависимости параметров транзисторов



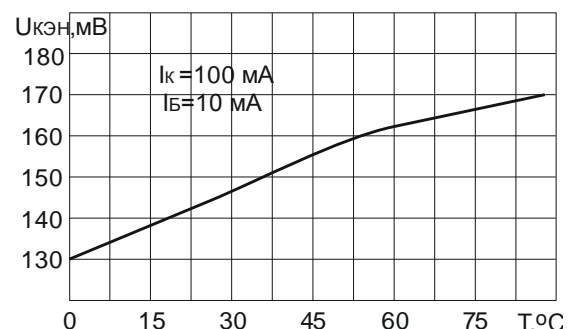
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.



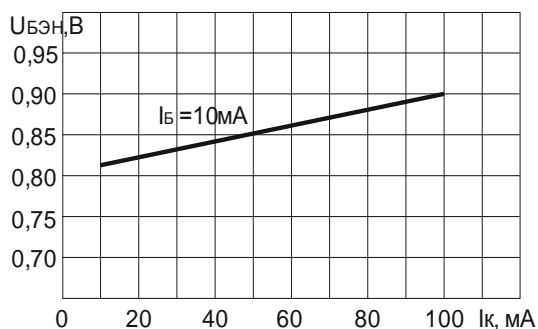
Зависимость статического коэффициента передачи тока от температуры



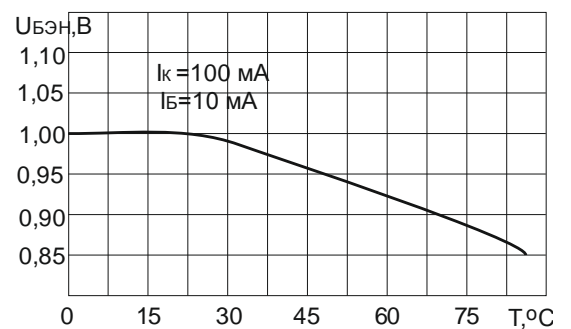
Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора.



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от температуры



Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора.



Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от температуры